

## Программа Одиннадцатой Международной конференции

### «Достижения Китайской электронной промышленности в производстве высоконадежной ЭКБ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»

26-27 мая 2026 года

г. Москва

Место проведения: ИКИ РАН (м. «Калужская»).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная 84/32

Схема проезда: <https://iki.cosmos.ru/contacts>

26 мая, вторник		
1	9:00-10:00	Регистрация участников
2	10:00	Открытие конференции
3	10:45	Доклад: «Соединители: Цилиндрические, комбинированные, ВЧ и D-Sub. Кабели. Гермовводы»
4	11:10	Доклад: «Обзор китайских производителей СВЧ микросхем на основе кремния (КМОП), GaAs, GaN, а также СвК на их основе»
5	11:35	Доклад: «Пассивные ЭРИ (конденсаторы, резисторы и пр.) и кварцевые генераторы»
6	12:00	Кофе-брейк
7	12:30	Доклад: «ПЛИС и СвК на их основе, АЦП, ЦАП, микросхемы памяти и др. цифровые компоненты китайских изготовителей»
8	12:50	Доклад: «Компоненты космического уровня качества для построения систем электропитания»
9	13:10	Доклад: «Опыт разработки и применения в КНР твердотельных накопителей данных для LEO/GEO»
10	13:30	Доклад: «Измерительный комплекс Load Pull PLANAR»
11	14:00	Обеденный перерыв
12	14:30	Экскурсия по Выставочному залу ИКИ РАН
13	15:00	Доклад (мнение): «Особенности пути развития отечественных FPGA разработчиков «Умственно-плюсовая деградация FPGA разработчиков»
14	15:20	Доклад о собственной среде разработки для ПЛИС от компании ВМТІ. Тренинг-центр по проектированию ПЛИС
15	15:40	Доклад: «Дискретные п/п, аналоговые ИС, изолированные ВИП и фильтры»
16	16:00	Доклад: «Модули памяти по технологии ЗД от компании ORBITA и ХМТІ»
17	16:20	Доклад о фактически измеренных результатах стойкости китайской ЭКБ и обеспечение стойкости РЭА к воздействию ТЗЧ в части тиристорного эффекта
18	16:40	Доклад об актуальных тенденциях оценки стойкости элементов и приборов к воздействию космической радиации в сотрудничестве с предприятиями КНР
19	17:00-17:30	Подведение итогов. Заключительное слово

27 мая, среда	
9:00-17:00	Работа по секции «ПЛИС и СвК на их основе, АЦП, ЦАП, микросхемы памяти и др. цифровые компоненты»
9:00-17:00	Работа по секции «СВЧ микросхемы на основе кремния (КМОП), GaAs, GaN, а также СвК на их основе»
9:00-17:00	Работа по секции «Твердотельные накопители данных для LEO/GEO»
9:00-17:00	Работа по секции «ВИП, аналоговые ИС и дискретные п/п для систем питания»
9:00-17:00	Работа по секции «Пассивные и электромеханические ЭРИ (конденсаторы, фильтры, резисторы, соединители, кабельные сборки, электромеханические реле) и кварцевые генераторы»

Работа в секции – это персональные встречи специалистов Российских заказчиков с техническими специалистами АО «Эпсилон». В ходе этой встречи специалисты будут ознакомлены с продукцией, детально обсудят технические вопросы и конкретные технические решения и задачи.

Для участия в работе секции необходима предварительная регистрация.

Контактное лицо по организации работы в секции: Трохова Снежана Александровна

## Программа Одиннадцатой Международной конференции

### «Достижения Китайской электронной промышленности в производстве высоконадежной ЭКБ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ»

28-29 мая 2026 года

г. Москва

Место проведения: ИКИ РАН (м. «Калужская»).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная 84/32

Схема проезда: <https://iki.cosmos.ru/contacts>

28 мая, четверг		
1	9:00-10:00	Регистрация участников
2	10:00	Открытие конференции
3	10:45	Доклад: «Изолированные и неизолированные источники питания и фильтры»
4	11:10	Доклад: «ПЛИС и СвК на их основе, АЦП, ЦАП, микросхемы памяти и др. цифровые компоненты китайских изготовителей»
5	11:35	Доклад: «Порядок применения ЭКБ ИП КНР разработчиками и серийными предприятиями, актуальные руководящие документы. Алгоритм согласования применения ЭКБ ИП КНР»
6	12:05	Кофе-брейк
7	12:30	Доклад: «Обзор китайских производителей СВЧ микросхем на основе кремния (КМОП), GaAs, GaN, а также СвК на их основе»
8	13:10	Доклад: «Соединители: Цилиндрические, комбинированные, ВЧ и D-Sub. Кабели. Гермовводы»
9	13:30	Доклад: «Обзор характеристик доступных акселерометров и гироскопов на примере номенклатуры фабрик из КНР»
10	14:00	Обеденный перерыв
11	14:30	Экскурсия по Выставочному залу ИКИ РАН
12	15:00	Доклад (мнение): «Особенности пути развития отечественных FPGA разработчиков «Умственно-плюсовая деградация FPGA разработчиков»
13	15:30	Доклад о собственной среде разработки для ПЛИС от компании ВМТІ. Тренинг-центр по проектированию ПЛИС
14	16:00	Доклад испытательного центра о практике и опыте испытаний ЭКБ КНР, порядке сертификации ЭКБ КНР
15	16:30	Доклад: «Пассивные ЭРИ (конденсаторы, резисторы и пр.) и кварцевые генераторы»
16	17:00	Доклад: «Аналоговые ИС и дискретные п/п для построения систем питания»
17	17:30-18:00	Подведение итогов. Заключительное слово

29 мая, пятница	
9:00-17:00	Работа по секции «ПЛИС и СвК на их основе, АЦП, ЦАП, микросхемы памяти и др. цифровые компоненты»
9:00-17:00	Работа по секции «СВЧ микросхемы на основе кремния (КМОП), GaAs, GaN, а также СвК на их основе»
9:00-17:00	Работа по секции «Компоненты навигации»
9:00-17:00	Работа по секции «ВИП, аналоговые ИС и дискретные п/п для систем питания»
9:00-17:00	Работа по секции «Пассивные и электромеханические ЭРИ (конденсаторы, фильтры, резисторы, соединители, кабельные сборки, электромеханические реле) и кварцевые генераторы»

Работа в секции – это персональные встречи специалистов Российских заказчиков с техническими специалистами АО «Эпсилон». В ходе этой встречи специалисты будут ознакомлены с продукцией, детально обсудят технические вопросы и конкретные технические решения и задачи.

Для участия в работе секции необходима предварительная регистрация.

Контактное лицо по организации работы в секции: Трохова Снежана Александровна +7 (981) 760-03-22.